

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP2004/009353

04. 8. 2004

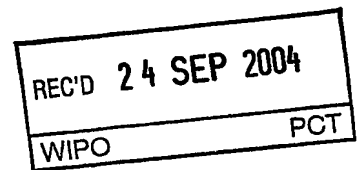
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 3 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 0 4 1 5 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 0 4 1 5 1]

出 願 人 京セラ株式会社
Applicant(s):

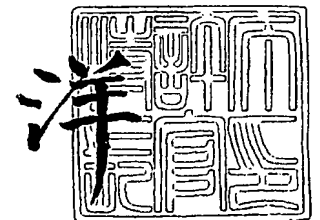


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 9 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 8 0 9 6 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 0000317651 -

【提出日】 平成15年 7月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 2 8 号 京セラ株式会社大阪玉造事業所内

【氏名】 東原 伸浩

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 2 8 号 京セラ株式会社大阪玉造事業所内

【氏名】 佐古田 秀人

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 2 8 号 京セラ株式会社大阪玉造事業所内

【氏名】 中川 敦之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 2 8 号 京セラ株式会社大阪玉造事業所内

【氏名】 段 儀治

【特許出願人】

【識別番号】 000006633

【住所又は居所】 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

【氏名又は名称】 京セラ株式会社

【代表者】 西口 泰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005337

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 セラミック電子部品の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 凸曲面を有した基体の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜を形成する工程 A と、

前記金属メッキ膜を樹脂フィルムの主面に転写し、しかる後、該樹脂フィルムの主面に前記金属メッキ膜を覆うようにしてセラミックスラリを塗布し、これを乾燥させることにより金属メッキ膜が埋設されたセラミックグリーンシートを形成する工程 B と、

前記セラミックグリーンシート及び金属メッキ膜を同時に加熱して、セラミックグリーンシートを焼成する工程 C と、を含むセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 2】 前記工程 C におけるセラミックグリーンシートの焼成温度が金属メッキ膜を形成している金属の融点よりも高く、かつ前記金属の再結晶温度よりも高いことを特徴とする請求項 1 に記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 3】 前記基体が円筒状もしくは円柱状を成しており、前記工程 A において、前記基体を軸周りに回転させながら、その一部をメッキ槽のメッキ液に浸漬するとともに、前記基体と前記メッキ槽との間のメッキ液に電界を印加することによって前記金属メッキ膜が形成されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 4】 前記基体が円筒状もしくは円柱状を成しており、前記基体の表面の曲率半径が 5 0 mm ～ 2 0 0 0 mm であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 5】 前記基体の表面に前記金属メッキ膜の析出領域を規制するマスク層が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 6】 前記マスク層が、ダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) もしくはグラファイト・ライク・カーボン (GLC) から成ることを特徴とする請求項 5 に記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 7】 前記マスク層の側面と下面との間に形成される角部の角度が 9 0 度

以下であることを特徴とする請求項 5 または請求項 6 に記載のセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 8】 前記金属メッキ膜を析出させる基体の表面が、窒化チタンアルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタン、炭化チタン、導電性 DLC の少なくとも一種から成るとともに、表面粗さが最大高さ R_y で $0.5\ \mu\text{m}$ 以下であり、且つ、前記基体表面の比抵抗が $10^{-3}\ \Omega\text{cm}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載のセラミック電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、セラミック層と所定パターンの導体層とを組み合わせ構成されているコンデンサやインダクタ、フィルタ、回路基板等のセラミック電子部品の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来より、コンデンサやインダクタ、フィルタ、回路基板等の電子部品を形成するのにセラミック材料が用いられている。

【0003】

このような従来のセラミック電子部品として、例えば、所定の誘電率を有した複数個のセラミック層を、間に第 1 の内部電極と第 2 の内部電極とを交互に介在させて積層するとともに、該積層体の側面や主面に前記第 1、第 2 の内部電極にそれぞれ電氣的に接続される一対の外部電極を設けてなる積層セラミックコンデンサ等がよく知られており、かかる積層セラミックコンデンサは、一対の外部電極を介して第 1 の内部電極と第 2 の内部電極との間に所定の電圧を印加し、第 1 の内部電極－第 2 の内部電極間に配されているセラミック層に所定の静電容量を形成することによってコンデンサとして機能するようになっている。

【0004】

また上述した積層セラミックコンデンサは以下の工程を経て製作される（例え

ば、特許文献1参照。)。

【0005】

まず、所定のセラミック材料粉末に有機バインダ及び有機溶剤を添加・混合してスラリー状の無機組成物を作製し、これを従来周知のドクターブレード法等によって所定厚みのシートに成形加工してセラミックグリーンシートを形成する。

【0006】

次に、得られたセラミックグリーンシートの主面に従来周知のスクリーン印刷等によってニッケル等の金属を主成分とする導体ペーストを所定パターンに印刷・塗布し、これを複数枚、積み重ねることによってセラミックグリーンシートの積層体を形成する。

【0007】

続いて、前記積層体を高温で焼成することによって導体ペーストを内部電極に、セラミックグリーンシートをセラミック層に成し、最後に、前記積層体の端面等に従来周知のディッピング法等によって導体ペーストを塗布し、これを焼き付けて外部電極を形成することによって積層セラミックコンデンサが製作される。

【0008】

【特許文献1】

特開 2000-243650 号公報

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、近年、電子機器の小型化に伴い、セラミック電子部品の小型化が求められており、上述した積層セラミックコンデンサの場合、個々のセラミック層や内部電極を薄く形成し、さらには高積層化、高容量化するための種々の検討がなされている。

【0010】

例えば、上述した従来の積層セラミックコンデンサにおいて、内部電極の厚みを薄くするには、内部電極の形成に使用されている導体ペースト中に含まれる金属粉末の平均粒径を、例えば、 $0.3\mu\text{m}$ 程度に極めて小さくすることが重要とされている。

【0011】

しかしながら、導体ペースト中に含まれている金属粉末の粒径を極めて小さくした場合、導体ペースト中で金属粉末同士が凝集することに起因して金属粉末の分散性が悪くなってしまうことから、スクリーン印刷等に適した特性を備えた導体ペーストを得ることが困難であるという欠点を有していた。

【0012】

また仮に、導体ペースト中に含まれている種々の成分を調整することによりスクリーン印刷等に適した特性をもった導体ペーストを得ることができたとしても、これをセラミックグリーンシート上に薄く塗布して焼成すると、焼成の際に導体ペースト中の金属粉末が移動することによって内部電極の連続性が著しく喪失される不都合があり、最悪の場合、内部電極が分断されてしまう欠点を有していた。

【0013】

そこで上記欠点を解消するために、内部電極となる金属メッキ膜を予め形成しておき、これをセラミックグリーンシートに転写することで厚みの薄い内部電極を形成することが考えられる。

【0014】

しかしながら、予め形成しておいた金属メッキ膜をセラミックグリーンシートに転写して内部電極を形成する場合、金属メッキ膜の析出時に金属メッキ膜中に大きな内部応力（引張応力）を生じるという不都合がある。それ故、金属メッキ膜の析出に使用される基材の表面が平坦である場合、金属メッキ膜を基材より剥離させると、金属メッキ膜は析出方向と反対側の方向に突出した形の反りを生じようとして、セラミックグリーンシートへの転写時、セラミックグリーンシートもしくは金属メッキ膜に変形やクラックを発生したり、或いは、焼成時にデラミネーションやクラックを発生するという欠点が誘発される。

【0015】

さらに、内部電極のない領域と内部電極のある領域は厚みが異なるので、複数のセラミックグリーンシートを積層すると、それぞれの内部電極の厚み差が累積されて、デラミネーションや電極が湾曲してショートといった電気不良が生じる

ことがある。

【0016】

本発明は上記欠点に鑑み案出されたもので、その目的は、導体層の厚みを薄くして小型のセラミック電子部品を製作することができ、しかも導体層やセラミック層に変形やクラック等の不具合が生じるのを有効に防止することができるセラミック電子部品の製造方法を提供することにある。

【0017】

【発明が解決するための手段】

本発明のセラミック部品の製造方法は、凸曲面を有した基体の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜を形成する工程Aと、前記金属メッキ膜を樹脂フィルムの主面に転写し、しかる後、該樹脂フィルムの主面に前記金属メッキ膜を覆うようにしてセラミックスラリを塗布し、これを乾燥させることにより金属メッキ膜が埋設されたセラミックグリーンシートを形成する工程Bと、前記セラミックグリーンシート及び金属メッキ膜を同時に加熱して、セラミックグリーンシートを焼成する工程Cと、を含むことを特徴とするものである。

【0018】

また本発明のセラミック部品の製造方法は、前記工程Cにおけるセラミックグリーンシートの焼成温度が金属メッキ膜を形成している金属の融点よりも高く、かつ前記金属の再結晶温度よりも高いことを特徴とするものである。

【0019】

更に本発明のセラミック部品の製造方法は、前記基体が円筒状もしくは円柱状を成しており、前記工程Aにおいて、前記基体を軸周りに回転させながら、その一部をメッキ槽のメッキ液に浸漬するとともに、前記基体と前記メッキ槽との間のメッキ液に電界を印加することによって前記金属メッキ膜が形成されることを特徴とするものである。

【0020】

また更に本発明のセラミック部品の製造方法は、前記基体が円筒状もしくは円柱状を成しており、前記基体の表面の曲率半径が50mm～2000mmであることを特徴とするものである。

【0021】

更にまた本発明のセラミック部品の製造方法は、前記基体の表面に前記金属メッキ膜の析出領域を規制するマスク層が形成されていることを特徴とするものである。

【0022】

また更に本発明のセラミック部品の製造方法は、前記マスク層が、ダイヤモンド・ライク・カーボン（DLC）もしくはグラファイト・ライク・カーボン（GLC）から成ることを特徴とするものである。

【0023】

更にまた本発明のセラミック部品の製造方法は、前記マスク層の側面と下面との間に形成される角部の角度が90度以下であることを特徴とするものである。

【0024】

また更に本発明のセラミック部品の製造方法は、前記金属メッキ膜を析出させる基体の表面が、窒化チタンアルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタン、炭化チタン、導電性DLCの少なくとも一種から成るとともに、表面粗さが最大高さR_yで0.5μm以下であり、且つ、前記基体表面の比抵抗が10⁻³Ωcm以下であることを特徴とするものである。

【0025】

【作用】

本発明によれば、凸曲面を有した基体の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜を形成し、得られた金属メッキ膜を樹脂フィルム上に転写した後、セラミックグリーンシートと一体化するようにしたことから、金属メッキ膜を析出させる際、金属メッキ膜中に内部応力（引張応力）が生じてても、金属メッキ膜を基体より剥離させると凸曲面状の金属メッキ膜は平坦化する方向に変形する。したがって、金属メッキ膜を樹脂フィルムの主面に転写した際、金属メッキ膜に変形やクラックが発生するといった不都合が有効に防止されるようになり、しかも樹脂フィルムは金属メッキ膜が転写された後も略平坦に維持されることから、樹脂フィルム上に塗布されるセラミックスラリの厚みを高精度に制御することができ、セラミック電子部品の生産性を向上させることができる。

【0026】

また上述のようにして得られるセラミックグリーンシートには、金属メッキ膜の存在する部位と存在しない部位との間に段差がなく、このようなセラミックグリーンシートを複数枚積層しても、内部電極の変形は抑制されることから、電気不良やデラミネーションの発生を有効に防止することができる利点もある。

【0027】

更に本発明によれば、上述した金属メッキ膜を、セラミックグリーンシートの焼成時、金属メッキ膜を形成する金属の再結晶温度よりも高く、かつ、融点より低い温度で熱処理することにより、焼成時の熱によって金属メッキ膜が溶けて金属メッキ膜を分断するといった不都合を生じることはなく、連続性に優れた導体層を形成することができる。なお、ここで、金属メッキ膜が連続性に優れた導体層となるのは、セラミックグリーンシートの焼成時、金属メッキ膜を形成している金属の再結晶化が進むことで金属が適度に軟化し、セラミックグリーンシート中のセラミック粒子が金属メッキ膜の表面に入り込むからであり、これによって金属メッキ膜とセラミックグリーンシートの密着力が向上し、構造欠陥の少ないセラミック電子部品が得られる。

【0028】

また更に本発明によれば、前記基体の表面に金属メッキ膜の析出領域を規制するマスク層を形成しておくことにより、フォトリソグラフィ等の煩雑な工程を経ることなく、基体をメッキ液に浸漬してメッキ槽との間に電界を印加するだけで所望するパターンの金属メッキ膜を容易に得ることができ、セラミック電子部品の生産性を向上させることが可能となる。

【0029】

更にまた本発明によれば、前記マスク層をDLCもしくはGLCにより形成しておけば、比較的厚みの薄く強度の強いマスク層が形成できる。さらに、このような膜は、前記基体との密着力が強く、十分な電気絶縁性を得ることができる上に、金属メッキ膜を基体より剥離させる際の剥離性を良好となすことができる。

【0030】

また更に本発明によれば、前記マスク層の側面と下面との間に形成される角部

の角度を90度以下になしておけば、基体と接する金属メッキ膜の下面の面積が上面の面積よりも小さくなることから、金属メッキ膜を樹脂フィルム上に転写する際、金属メッキ膜の外周部がマクス層に引っ掛かることは殆どなく、金属メッキ膜の‘抜け’を良好となすことができる。

【0031】

更にまた本発明によれば、金属メッキ膜が析出される基体の表面を窒化チタン、アルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタン、炭化チタン、導電性DLCの少なくとも一種により形成するとともに、基体表面の表面粗さを最大高さRyで $0.5\mu\text{m}$ 以下に設定し、その比抵抗を $10^{-3}\Omega\text{cm}$ 以下に設定しておくことにより、基体の表面に金属メッキ膜を析出させる際、基体とメッキ槽との間の電流密度はより均一なものとなり、金属メッキ膜の厚みをより等しく揃えることができるようになる。しかもこの場合、基体表面の硬度は高く、表面状態は極めて平滑であることから、金属メッキ膜の剥離性も良好である。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を添付図面に基づいて詳細に説明する。

【0033】

図1は本発明の一実施形態に係る製造方法によって製作したセラミック電子部品としての積層セラミックコンデンサを示す断面図であり、同図に示す積層セラミックコンデンサ1は、大略的に、絶縁層2と、導体層としての内部電極3と、セラミック層4と、外部電極5とで構成されている。

【0034】

積層セラミックコンデンサ1は、内部電極3と所定の誘電率を有したセラミック層4とを交互に積層して直方体形状の積層体を形成するとともに、該積層体の上下両面にセラミック層4と同一材料からなる絶縁層2を形成し、更に前記積層体の両端部に内部電極3と電気的に接続される外部電極5を被着・形成した構造を有している。

【0035】

また、積層セラミックコンデンサ 1 の外形は、例えば、巾 1.2 mm、長さ 2 mm、高さ 1.2 mm の寸法にて形成され、セラミック層 4 や内部電極 3 の積層数は 30 層～600 層に設定される。

【0036】

また、前記内部電極 3 の厚みは $0.5\ \mu\text{m}$ ～ $2.0\ \mu\text{m}$ 程度、またセラミック層 4 の厚みは $1.0\ \mu\text{m}$ ～ $4.0\ \mu\text{m}$ 程度に設定される。

【0037】

これらセラミック層 4 の材質や厚み、積層数、内部電極 3 の対向面積等は、所望する静電容量の大きさによって適宜、決定される。

【0038】

かかる積層セラミックコンデンサ 1 は、外部電極 5 を介して隣合う内部電極間 3-3 に所定の電圧を印加し、内部電極間 3-3 に配されているセラミック層 4 に所定の静電容量を形成することによってコンデンサとして機能する

次に、上述した積層セラミックコンデンサの製造方法について図 2 乃至図 4 を用いて説明する。

【0039】

図 2 は本発明の製造方法に用いられる製造装置を模式的に示す図、図 3 は図 2 の製造装置に用いられる基体 11 を図 2 の A 方向から見た平面図、図 4 は図 3 の製造装置に用いられる基体表面の構造を示す拡大断面図である。

【0040】

<工程 1>

まず、凸曲面を有した基体 11 の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜 9 を形成する。

【0041】

前記基体 11 は、例えば、ステンレス等によって曲率半径 200 mm、長さ 200 mm の円柱形状もしくは円筒状をなすように形成され、その表面には比抵抗が $10^{-4}\ \Omega\text{cm}$ の窒化チタンによって成膜した導電性膜 7 が形成される。また前記導電性膜 7 上には、巾 $1.2\ \mu\text{m}$ ×長さ $2\ \mu\text{m}$ の矩形状領域が複数個、露出するように、厚み $1\ \mu\text{m}$ 程度の DLC から成るマスク層 8 が形成される。このマ

スク層 8 の側面と下面（基体 11 の表面）とで形成される角部の角度 α は、例えば、90 度～85 度に設定される。

【0042】

このような基体 11 の下部領域が、メッキ槽 16 に注入されているメッキ液 17 に浸漬されるようにして、基体 11 を所定の回転速度で回転軸 12 の軸周りに回転させながら、基体 11 の電流密度が、例えば、 $2\text{ A/dm}^2 \sim 15\text{ A/dm}^2$ となるようにメッキ槽 16 との間に所定の電位差を設け、前述した基体 11 の各矩形状領域に電解メッキを施すことにより基体 11 の凸曲面に沿って金属メッキ膜 9 が形成される。

【0043】

このように、円筒状もしくは円柱状の基体 11 をその軸周りに回転させながら、メッキ槽 16 のメッキ液 17 に浸漬するとともに、基体 11 とメッキ槽 16 との間のメッキ液 17 に電界を印加して金属メッキ膜 9 を形成することにより、金属メッキ膜 9 を連続的に形成することができ、これによって積層セラミックコンデンサの生産性を向上させることが可能となる。しかもこの場合、基体 11 とメッキ槽 17 との間の電流密度は略均一になることから、金属メッキ膜 9 を略一定の厚みで形成することもできるようになる。

【0044】

尚、前記基体 11 の回転軸 12 は、その両端部が図示しない軸受けによって支持されており、基体 11 が上下左右の移動しない構造となっている。このような回転軸 12 と原動機の主軸とを連結して、原動機の回転運動を伝達させることにより基体 11 が所定の速度で軸周りに回転するようになっている。

【0045】

また、基体 11 の回転軸 12 は回転ブラシを介して電源装置 13 と電氣的に接続されており、これによって基体 11 を電解メッキにおける陰極として機能させるようになっている。

【0046】

一方、メッキ槽 16 は、その内部でメッキ液 17 を保持するとともに、電解メッキに際して陽極として機能するものであり、その内面は、例えば、基体 11 の

外表面と同心円上に配され、メッキ槽 16 との間にメッキ液 17 を充填するための所定の間隙、例えば、5～30 mm の間隙を形成している。

【0047】

このようなメッキ槽 16 内のメッキ液 17 は、均質な金属メッキ膜 9 を得るために、電界メッキを行う際、循環装置 14 等によって常に所定の方向に流動させておくことが好ましく、また、純度の高いニッケル金属メッキ膜 9 を析出するには、メッキ槽 18 の内面を金属メッキ膜 9 と同質の金属材料によって形成しておくことが好ましい。

【0048】

そして、上述のような基体 11 の表面に形成された金属メッキ膜 9 は、基体 11 の回転によってメッキ液 17 中より引き上げられた後、洗浄手段 15 によって水洗浄及び乾燥が行われる。

【0049】

尚、上述した基体 11 の材料としては、先に述べたステンレス以外にも、鉄、アルミニウム、銅、ニッケル、チタン、タンタル、モリブデン等の導電性を備えた金属材料が用いられ、これらの金属材料の中でも、耐薬品性の観点から、ステンレス、チタンを用いるのが好ましい。

【0050】

また、前記基体表面の曲率半径は、50 mm～2000 mm の範囲に設定しておくのが好ましく、メンテナンスの容易性や生産性等の観点からは 50 mm～500 mm に設定しておくのが特に好ましい。

【0051】

更に、上述した基体表面の表面粗さは、例えば、最大高さ R_y で $0.5 \mu\text{m}$ 以下に設定され、より好ましくは $R_y 0.2 \mu\text{m}$ 以下に設定する。ここで、基体表面の表面粗さを小さくしておくのは、金属メッキ膜 9 の厚みが薄くなると、基体 11 の凸部が金属メッキ膜 9 に転写されて金属メッキ膜 9 にピンホールが形成され、これを熱処理した際に構造欠陥を生じてしまう恐れがあるからである。

【0052】

また一方、前記基体 11 の表面に形成される導電性膜 7 としては、硬質でピン

ホール等の膜欠陥が少ない、滑らかな膜質のものを用いるのが好ましい。かかる導電性膜 7 としては、比抵抗が $10^{-2} \Omega \text{cm}$ 以下のものを用いるのが好ましく、電解メッキの際の電流密度の観点からは、比抵抗が $10^{-3} \Omega \text{cm}$ 以下のもの、例えば、窒化チタンアルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタン、炭化チタン、導電性 DLC 等によって導電性膜 7 を形成するのが好ましい。また、これらの材料の中でも、金属メッキ膜 9 の剥離性を考慮すると、窒化チタンアルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタンが特に好ましく、耐久性の観点からは、窒化チタンが好ましい。

【0053】

尚、前記導電性膜 7 は、従来周知の薄膜形成法、例えば、スパッタリング法、イオンプレーティング法、化学的気相成長法 (CVD) 等によって形成される。

【0054】

また、前記導電性膜 7 の表面に形成されるマスク層 8 は、金属メッキ膜 9 の析出領域を規制するためのもので、金属メッキ膜が表面に析出されない程度の十分な電気絶縁性を備え、その比抵抗は、例えば、 $10^4 \Omega \text{cm}$ 以上に設定され、ビッカース硬度 H_v が 1000 以上、摩擦係数 μ が 0.3 以下の膜によって形成される。このような諸特性を満足することができる材料としては、例えば、アモルファス構造の DLC や GLC 等が挙げられる。

【0055】

このように、基体 11 の表面に金属メッキ膜 9 の析出領域を規制するマスク層 8 を形成しておくことにより、フォトリソグラフィ等の煩雑な工程を経ることなく、基体 11 をメッキ液 17 に浸漬してメッキ槽 16 との間に電界を印加するだけで所望するパターンの金属メッキ膜 9 を容易に得ることができ、積層セラミックコンデンサの生産性を向上させることが可能となる。

【0056】

かかるマスク層 8 の厚みは、所望する金属メッキ膜 9 の厚みによって任意に設定され、金属メッキ膜 9 の厚みと同じか、或いは、金属メッキ膜 9 の厚みよりもやや厚く形成することが好ましい。これは、析出途中の金属メッキ膜 9 がマスク層 8 を乗り越えて広がるのを防止するためである。

【0057】

尚、前記マスク層 8 は、例えば、DLC、GLC等を従来周知のスパッタリング法、イオンプレーティング法、CVD法等の薄膜形成法によって基体 11 の表面に所定厚みに被着・形成し、しかる後、従来周知のフォトエッチング法等を採用して、得られた膜を金属メッキ膜 9 の析出領域に対応する複数の開口部を有した所定パターンに加工することによって形成される。

【0058】

このようなマスク層 8 の材質として用いられる DLC や GLC は、その電気抵抗が高いことから、マスク層 8 の表面にメッキが析出することはない上に、表面の剥離性が良好で、摩擦抵抗も小さいため、金属メッキ膜 9 を本実施形態における被転写体である樹脂フィルム 21 に対して転写する際、被転写体が損傷を受けることは少なく、基体 11 の耐久性が高められ、長期にわたって繰り返し使用しても高品質の金属メッキ膜 9 を形成することができる。

【0059】

そして、上述のような基体 11 の表面に形成される金属メッキ膜 9 は、ニッケル、銅、銀、金、プラチナ、パラジウム、クロム等やこれら金属の合金からなり、従来周知の電解メッキ法にて基体 11 の表面に析出・形成される。

【0060】

かかる金属メッキ膜 9 の形成には、金属メッキ膜 9 をニッケルで形成する場合、例えば、スルファミン酸ニッケルメッキ液が用いられ、かかるスルファミン酸ニッケルメッキ液を用いて金属メッキ膜 9 を形成することにより、内部応力の少ない金属メッキ膜 9 を形成することができる。尚、スルファミン酸ニッケルメッキ液としては、例えば、塩化ニッケル 30 g/リットル、スルファミン酸ニッケル 300 g/リットル、ほう酸 30 g/リットルの組成を有した水溶液等が用いられ、その pH 値は、例えば、3.0~4.2 に設定され、金属メッキ膜 9 中の内部応力を小さく抑えるには、pH 値を 3.5~4.0 に設定しておくことが好ましい。またメッキ液の温度は、例えば、25℃~70℃に設定され、金属メッキ膜 9 中の内部応力を小さく抑えるには、45~50℃に設定しておくことが好ましい。

【0061】

ここで、上述したメッキ液17には、必要に応じて、ホウ酸、ギ酸ニッケル、酢酸ニッケル等から成るpH緩衝剤やラウリル硫酸ナトリウム等から成るピット防止剤、ベンゼンやナフタレン等の芳香族炭化水素にスルホン酸、スルホン酸塩、スルホンアミド、スルホンイミド等を付与した化学物質等から成る応力減少剤、芳香族スルホン酸やその誘導体から成る硬化剤、ブチンジオール、2ブチン1,4ジオール、エチレンシアンヒドリン、ホルムアルデヒド、クマリン、ピリミジン、ピラゾール、イミダゾール等から成る平滑剤等を適宜、添加して用いてもよいことは言うまでもない。尚、応力減少剤の具体的な材料としては、例えば、サッカリン、パラトルエンスルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、ベンゼンスルホンイミド、ベンゼンジスルホン酸ナトリウム、ベンゼントリスルホン酸ナトリウム、ナフタレンジスルホン酸ナトリウム、ナフタレントリスルホン酸ナトリウム等が挙げられる。

【0062】

<工程2>

次に、工程1により得た金属メッキ膜9を樹脂フィルム20上に転写する。

【0063】

樹脂フィルム20としては、例えば、厚み $20\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ のポリエチレンテレフタレートフィルム（PETフィルム）等の主面に厚み $0.05\mu\text{m}$ ～ $10\mu\text{m}$ の粘着層21を形成したものが用いられる。粘着層21は、例えば、アクリル系（溶剤系）、アクリルエマルジョン系（水系）、ブチラール系、フェノール系、シリコン系、エポキシ系等の粘着剤（溶剤系）をPETフィルム等の主面に塗布して乾燥することによって得られ、乾燥後の粘着力が例えば、 $0.1\text{N}/\text{cm}$ となるように調整しておくことが好ましい。

【0064】

このような樹脂フィルム20は送り出し部22によって基体11側へ順次供給され、粘着層21が形成されている側を金属メッキ膜9が形成されている基体11の表面に対し加圧ローラ23によって、例えば、 10N の押圧力で加圧することによって樹脂フィルム20上に金属メッキ膜9が転写させる。その後、樹脂フ

フィルム 20 は基体表面の周速度と同じ速度で巻き取り部 24 によって巻き取られる。

【0065】

このとき、マスク層 8 の側面と下面との間に形成される角部の角度 α を 90 度以下になしておけば、基体 11 と接する金属メッキ膜 9 の下面の面積が上面の面積よりも小さくなることから、金属メッキ膜 9 を樹脂フィルム 20 等に転写する際、金属メッキ膜 9 の外周部がマスク層 8 に引っ掛かることは殆どなく、金属メッキ膜 9 の「抜け」を良好となすことができる。

【0066】

尚、前記粘着層 21 としては、比較的低温で確実に熱分解される材料により形成され、具体的には、金属メッキ膜 9 に付着した場合であっても焼成に際して熱分解するアクリル系（溶剤系）、アクリルエマルジョン系（水系）、ブチラール系の粘着剤を用いるのが好ましく、これらの中でも剥離性の良好なアクリル系粘着剤を用いるのが特に好ましい。このような粘着層 21 の粘着力は、例えば、0.005 N/cm \sim 1.0 N/cm、また転写性の観点からは、0.01 N/cm \sim 1.0 N/cm のものを用いるのが特に好ましく、剥離性の観点からは、0.01 N/cm \sim 0.2 N/cm のものを用いるのが好ましい。

【0067】

また、加圧ロール 23 としては、樹脂フィルム 20 を基体 11 に対して均等に加圧することができるように、表面部分をウレタンゴムコート、ネオプレーンゴムコート、天然ゴムコート等の弾力材料によって形成したものを用いることが好ましい。

【0068】

<工程 3>

次に、金属メッキ膜 9 が転写されている樹脂フィルム 20 の主面に、金属メッキ膜 9 を覆うようにしてセラミックスラリ 26 を塗布し、これを乾燥させることによりセラミックグリーンシート 26' を形成する。

【0069】

セラミックスラリ 26 としては、例えば、チタン酸バリウム、チタン酸カルシ

ウム、チタン酸ストロンチウム等を主成分とする誘電体材料粉末に適当な有機溶剤、有機バインダ等を添加・混合して泥漿状となすことによって得られ、これを従来周知のダイコート法等を採用し、塗布手段 27 を用いて樹脂フィルム 20 上に例えば $1\mu\text{m}$ ~ $20\mu\text{m}$ の厚みに塗布し、しかる後、乾燥手段 28 によって例えば 70°C ~ 85°C の温度で約 30 秒 ~ 60 秒間加熱し、セラミックスラリ 26 中に存在する有機溶剤の多くを蒸発させることによってセラミックグリーンシート 26' が得られる。

【0070】

尚、前記乾燥手段 28 としては、熱風、赤外線、マイクロ波等を利用した乾燥手段や、これらを組み合わせて利用する乾燥手段が好適に採用される。

【0071】

これによって樹脂フィルム 20 の主面には、金属メッキ膜 9 が埋設された状態のセラミックグリーンシート 26' が形成され、金属メッキ膜 9 とセラミックグリーンシート 26' とが一体化される。

【0072】

このようなセラミックグリーンシート 26' は、金属メッキ膜 9 の存在する部位と存在しない部位との間に段差がなく、得られたセラミックグリーンシート 26' を後述する積層工程 4 において複数枚積層しても、内部電極の変形が抑制されるため、電気不良やデラミネーションの発生を有効に防止することができる。

【0073】

<工程 4>

次に、前述の工程 3 で得た金属メッキ膜 9 付きのセラミックグリーンシート 26 を複数枚準備して、これらを相互に圧着・積層することにより積層体を形成する。

【0074】

このような積層体は、例えば、 60°C の温度で加熱しながら 0.9MPa の圧力で仮圧着され、その後、従来周知の静水圧プレス等によって 70°C の温度、 50MPa の圧力で、積層体を構成する金属メッキ膜 9 付きのセラミックグリーンシート 26 を相互に圧着させることによって形成される。

【0075】

<工程5>

そして最後に、工程4で得た積層体を所定形状に切断し、これらを高温で焼成する。

【0076】

ここで重要なのは、積層体の焼成温度を、金属メッキ膜9を形成している金属の融点よりも低く、かつ該金属の再結晶温度よりも高い温度で焼成することであり、これによってセラミックグリーンシート26は積層セラミックコンデンサのセラミック層4となり、金属メッキ膜9は内部電極3となる。

【0077】

例えば、金属メッキ膜9がニッケルから成る場合、ニッケルの再結晶温度は500～550℃で、ニッケルの融点は1450℃であるため、積層体の焼成は、例えば、1300℃の温度で行われる。

【0078】

このように金属メッキ膜9を、該メッキ膜9を形成する金属の融点より低い温度で焼成することにより、焼成時に金属メッキ膜9が熔けて金属メッキ膜9が分断されるといった不都合が確実に防止され、連続性に優れた内部電極3を形成することができる。

【0079】

またこの場合、積層体の焼成温度は、金属メッキ膜9を形成している金属の再結晶温度よりも高く設定されているため、焼成時に金属メッキ膜9を形成している金属の再結晶化が進むことで金属が適度に軟化し、セラミックグリーンシート26中のセラミック粒子が金属メッキ膜9の表面に入り込むことによって金属メッキ膜9とセラミックグリーンシート26との密着力を向上せしめ、その結果、構造欠陥の少ない積層セラミックコンデンサが得られるようになる。

【0080】

<工程6>

そして最後に、積層体の両端部に外部電極用の導体ペーストを塗布して焼成し、更にメッキ処理を施すことによって外部電極5が形成され、これによって製品

としての積層セラミックコンデンサ 1 が完成する。

【0081】

以上のような第 1 実施形態の製造方法によれば、凸曲面を有した基体 11 の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜 9 を形成し、得られた金属メッキ膜 9 をセラミックグリーンシート 26 の主面に転写するようにしたことから、金属メッキ膜 9 を析出させる際、金属メッキ膜 9 中に内部応力（引張応力）が生じてても、金属メッキ膜 9 を基体 11 より剥離させると凸曲面状の金属メッキ膜 9 は平坦化する方向に変形する。したがって、金属メッキ膜 9 を樹脂フィルム 20 の主面に転写した際、金属メッキ膜 9 に変形やクラックが発生するといった不都合が有効に防止されるようになり、しかも樹脂フィルム 20 は金属メッキ膜 9 が転写された後も略平坦に維持されることから、樹脂フィルム 20 上に塗布されるセラミックスラリ 26 の厚みを高精度に制御することができ、積層セラミックコンデンサ 1 の生産性を向上させることができる。

【0082】

尚、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更、改良等が可能である。

【0083】

例えば、上述の実施形態においては、セラミックスラリ 26 を従来周知のダイコート法によって樹脂フィルム 20 上に塗布する場合について説明したが、これに代えて、セラミックスラリ 26 をロールコート法やスクリーン印刷法等の他の塗布法によって樹脂フィルム 20 上に塗布するようにしても構わない。

【0084】

また図 2 には、塗布手段 27 を樹脂フィルム 20 の下方に配置させて、セラミックスラリ 26 を樹脂フィルム 20 の下方より塗布する場合について示したが、セラミックスラリ 26 は樹脂フィルム 20 の上方より塗布したり、樹脂フィルム 20 の側方より塗布するようにしても構わない。

【0085】

更に上述した実施形態において、塗布手段 27 に対して樹脂フィルム 20 の搬送方向下流側にドクターブレードを配置させて、樹脂フィルム 20 上に塗布され

るセラミックスラリ 26 の厚みを均一化するようにしても良い。

【0086】

更に上述した実施形態においては、積層セラミックコンデンサを製造する場合を例にとって説明したが、積層セラミックコンデンサ以外のセラミック電子部品、例えば、インダクタ、フィルタ、回路基板等の他のセラミック電子部品を製造する場合においても本発明が適用可能であることは言うまでもない。

【0087】

【発明の効果】

本発明によれば、凸曲面を有した基体の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜を形成し、得られた金属メッキ膜を樹脂フィルム上に転写した後、セラミックグリーンシートと一体化するようにしたことから、金属メッキ膜を析出させる際、金属メッキ膜中に内部応力（引張応力）が生じてても、金属メッキ膜を基体より剥離させると凸曲面状の金属メッキ膜は平坦化する方向に変形する。したがって、金属メッキ膜を樹脂フィルムの主面に転写した際、金属メッキ膜に変形やクラックが発生するといった不都合が有効に防止されるようになり、しかも樹脂フィルムは金属メッキ膜が転写された後も略平坦に維持されることから、樹脂フィルム上に塗布されるセラミックスラリの厚みを高精度に制御することができ、セラミック電子部品の生産性を向上させることができる。

【0088】

また上述のようにして得られるセラミックグリーンシートには、金属メッキ膜の存在する部位と存在しない部位との間に段差がなく、このようなセラミックグリーンシートを複数枚積層しても、内部電極の変形は抑制されることから、電気不良やデラミネーションの発生を有効に防止することができる利点もある。

【0089】

更に本発明によれば、上述した金属メッキ膜を、セラミックグリーンシートの焼成時、金属メッキ膜を形成する金属の再結晶温度よりも高く、かつ、融点より低い温度で熱処理することにより、焼成時の熱によって金属メッキ膜が溶けて金属メッキ膜を分断するといった不都合を生じることはなく、連続性に優れた導体層を形成することができる。なお、ここで、金属メッキ膜が連続性に優れた導体

層となるのは、セラミックグリーンシートの焼成時、金属メッキ膜を形成している金属の再結晶化が進むことで金属が適度に軟化し、セラミックグリーンシート中のセラミック粒子が金属メッキ膜の表面に入り込むからであり、これによって金属メッキ膜とセラミックグリーンシートの密着力が向上し、構造欠陥の少ないセラミック電子部品が得られる。

【0090】

また更に本発明によれば、前記基体の表面に金属メッキ膜の析出領域を規制するマスク層を形成しておくことにより、フォトエッチング等の煩雑な工程を経ることなく、基体をメッキ液に浸漬してメッキ槽との間に電界を印加するだけで所望するパターンの金属メッキ膜を容易に得ることができ、セラミック電子部品の生産性を向上させることが可能となる。

【0091】

更にまた本発明によれば、前記マスク層をDLCもしくはGLCにより形成しておけば、比較的厚みの薄く強度の強いマスク層が形成できる。さらに、このような膜は、前記基体との密着力が強く、十分な電気絶縁性を得ることができる上に、金属メッキ膜を基体より剥離させる際の剥離性を良好となすことができる。

【0092】

また更に本発明によれば、前記マスク層の側面と下面との間に形成される角部の角度を90度以下になしておけば、基体と接する金属メッキ膜の下面の面積が上面の面積よりも小さくなることから、金属メッキ膜を樹脂フィルム上に転写する際、金属メッキ膜の外周部がマスク層に引っ掛かることは殆どなく、金属メッキ膜の‘抜け’を良好となすことができる。

【0093】

更にまた本発明によれば、金属メッキ膜が析出される基体の表面を窒化チタン、アルミニウム、窒化クロム、窒化チタン、窒化チタンクロム、炭窒化チタン、炭化チタン、導電性DLCの少なくとも一種により形成するとともに、基体表面の表面粗さを最大高さR_yで0.5 μm以下に設定し、その比抵抗を10⁻³ Ω cm以下に設定しておくことにより、基体の表面に金属メッキ膜を析出させる際、基体とメッキ槽との間の電流密度はより均一なものとなり、金属メッキ膜の厚み

をより等しく揃えることができるようになる。しかもこの場合、基体表面の硬度は高く、表面状態は極めて平滑であることから、金属メッキ膜の剥離性も良好である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態に係る製造方法によって製作したセラミック電子部品としての積層セラミックコンデンサを示す断面図である。

【図 2】

本発明の製造方法に用いられる製造装置の構成を模式的に示す図である。

【図 3】

図 2 の製造装置に用いられる基体 11 を図 2 の A 方向から見た平面図である。

【図 4】

図 3 の製造装置に用いられる基体表面の構造を示す拡大断面図である。

【符号の説明】

- 1・・・積層セラミックコンデンサ（セラミック電子部品）
- 2・・・絶縁層
- 3・・・内部電極（導体層）
- 4・・・セラミック層
- 5・・・外部電極
- 7・・・導電性膜
- 8・・・マスク層
- 9・・・金属メッキ膜
- 11・・・基体
- 12・・・回転軸
- 13・・・電源装置
- 14・・・循環装置
- 15・・・乾燥部
- 16・・・メッキ槽（陽極）
- 17・・・メッキ液

2 0 . . . 樹脂フィルム

2 1 . . . 粘着層

2 2 . . . 送り出し部

2 3 . . . 加圧ローラ

2 4 . . . 巻き取り部

2 6 . . . セラミックスラリ

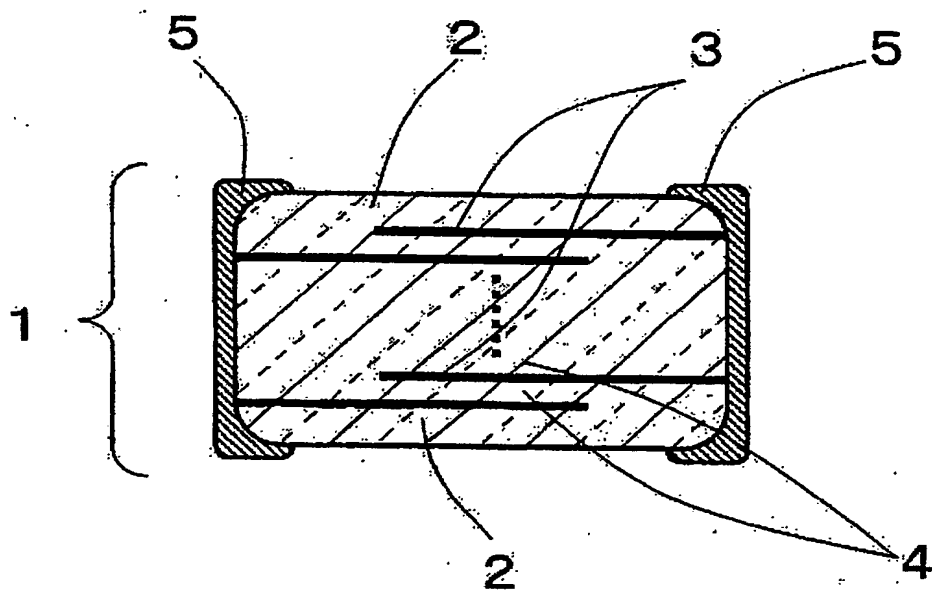
2 6 ' . . . セラミックグリーンシート

2 7 . . . 塗布手段

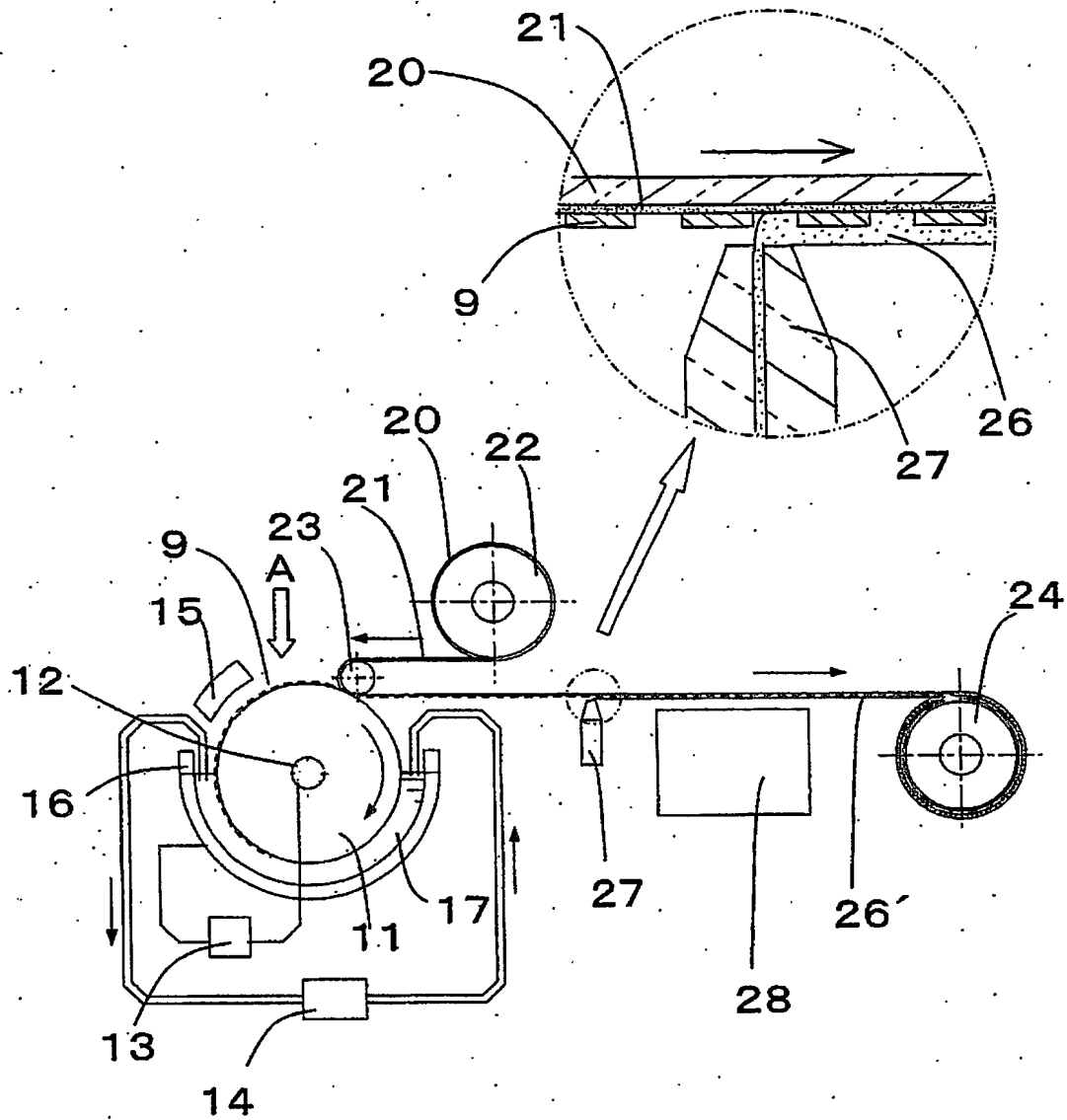
2 8 . . . 乾燥手段

【書類名】 図面

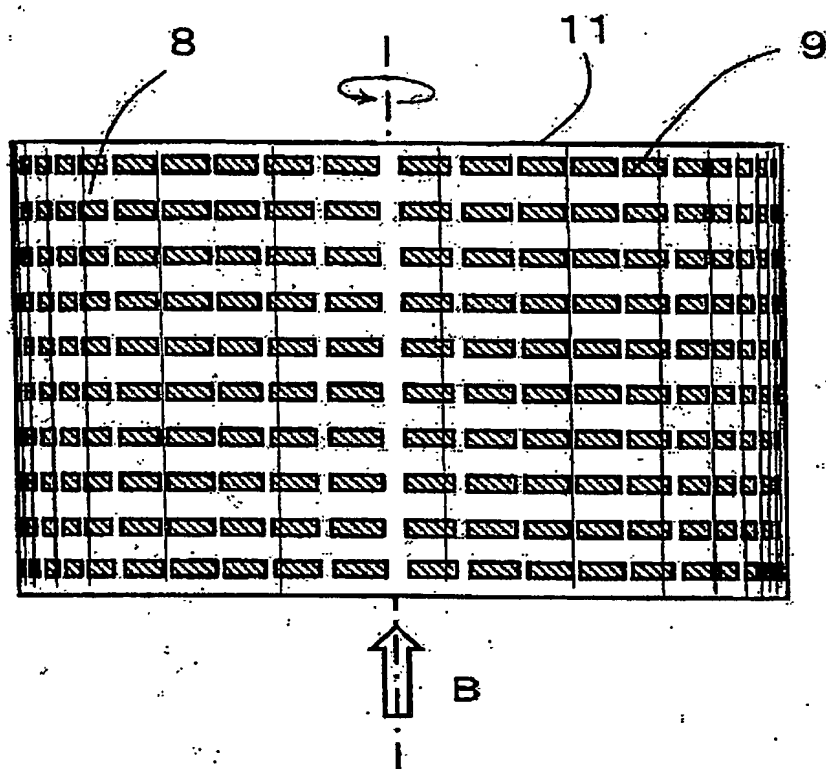
【図 1】



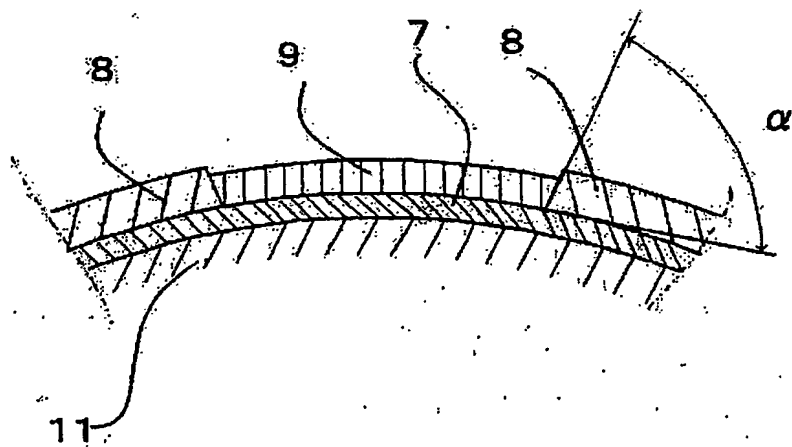
【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 導体層の厚みを薄くして小型のセラミック電子部品を製作することができ、しかも導体層やセラミック層に変形やクラック等の不具合が生じるのを有効に防止することができるセラミック電子部品の製造方法を提供する。

【解決手段】 凸曲面を有した基体の表面に断面が凸曲面状の金属メッキ膜を形成する工程Aと、前記金属メッキ膜を樹脂フィルムの主面に転写し、しかる後、該樹脂フィルムの主面に前記金属メッキ膜を覆うようにしてセラミックスラリを塗布し、これを乾燥させることにより金属メッキ膜が埋設されたセラミックグリーンシートを形成する工程Bと、前記セラミックグリーンシート及び金属メッキ膜を同時に加熱して、セラミックグリーンシートを焼成する工程Cとによってセラミック電子部品を製造する。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 3 - 2 0 4 1 5 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 6 3 3]

1. 変更年月日

1 9 9 8 年 8 月 2 1 日

[変更理由]

住所変更

住 所

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

氏 名

京セラ株式会社